

REFERENCE

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | 2006

Extension of epitaxy workplace in the V12 object



 **Rozšíření pracoviště epitaxe v objektu V12**

Investor, lokalita:

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.; Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Doba plnění:

12/2005 – 6/2006

Popis:

Projektové práce:

Projekt pro stavební povolení včetně vyřízení stavebního povolení; Projekt pro realizaci stavby; Projekt skutečného provedení stavby.

Realizace:

Dodávka čistých prostorů v souladu s normou ISO EN 14 644 (US FS 209E) pro výrobu epitaxních vrstev v mikroelektronice. Dodávka včetně vzduchotechniky, zdroje chladu, zdroje tepla, silnoproudé elektroinstalace, měření a regulace. Součástí dodávky byla rovněž výstavba stanice HCL a zajištění energií, čistých medií a připojení výrobní technologie na tyto energie a média.

Celková plocha čistých prostor	459 m²
ISO Class 5 (100, dosaženo 10)	24 m ²
ISO Class 6 (1 000)	201 m ²
ISO Class 7 (10 000)	85 m ²
ISO Class 8 (100 000)	149 m ²

Extention of epitaxy workplace in the V12 object

Investor, locality: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic

Implementation term: 12/2005 – 6/2006

Description:

Project works:

Project for building approval incl. building approval execution; realization project; as-built-project.

Realization:

Delivery of cleanrooms according to ISO EN 14 644 (US FS 209E) for epitaxial films production in microelectronics, incl. HVAC, chill source, heat source, heavy current, measurement and control. Construction of HCI station and ensured energy, pure media and connection of production technology to these energy and media.

Total area of clean rooms	459 m²
ISO Class 5 (100, dosaženo 10)	24 m ²
ISO Class 6 (1 000)	201 m ²
ISO Class 7 (10 000)	85 m ²
ISO Class 8 (100 000)	149 m ²

Расширение участка эпитаксии в корпусе V12

Инвестор, место: ООО «ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC»; г. Рожнов под Радгоштем, Чешская Республика
 Срок исполнения: 12/2005 – 6/2006

Описание: Проектные работы:
 Выполнение проекта для получения разрешения на строительство, включая оформление разрешения на строительство; выполнение проекта по реализации строительства; выполнение проекта действительного выполнения строительства.

Реализация:
 Поставка чистых помещений согласно ISO EN 14 644 (US FS 209E) для производства эпитаксиальных слоев в микроэлектронике. Включая поставку и монтаж вентиляционного оборудования, источника холодоснабжения, источника теплоснабжения, распределительных сетей сильного тока, измерения и регуляции. В поставку входили также создание станции HCL и подключение к энергиям, подключение чистых сред, производственной технологии к этим энергиям и чистым средам.

Общая площадь чистых помещений	459 м²
ISO Class 5 (100, достигнуто 10)	24 м ²
ISO Class 6 (1 000)	201 м ²
ISO Class 7 (10 000)	85 м ²
ISO Class 8 (100 000)	149 м ²



Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006



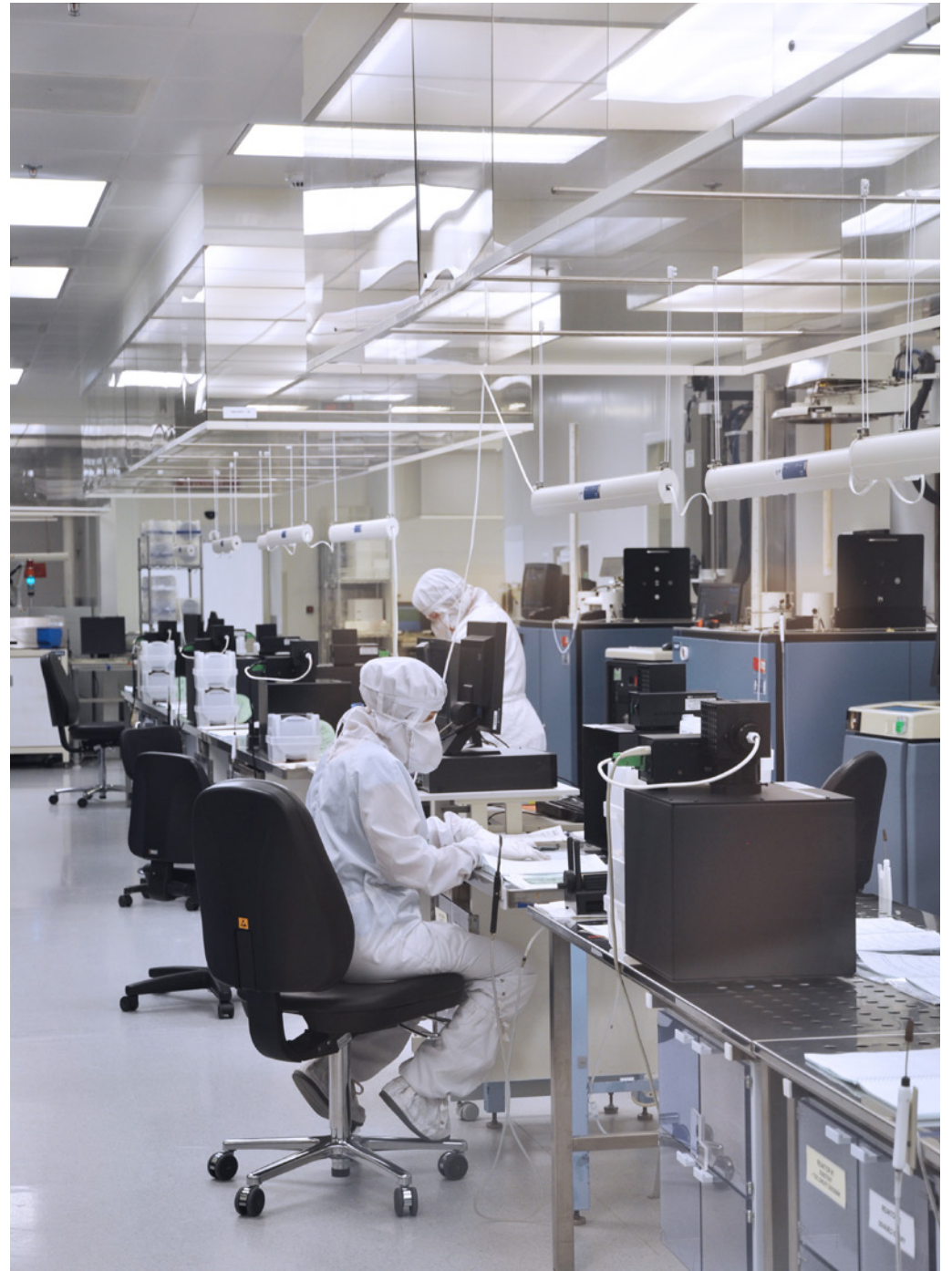
Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006



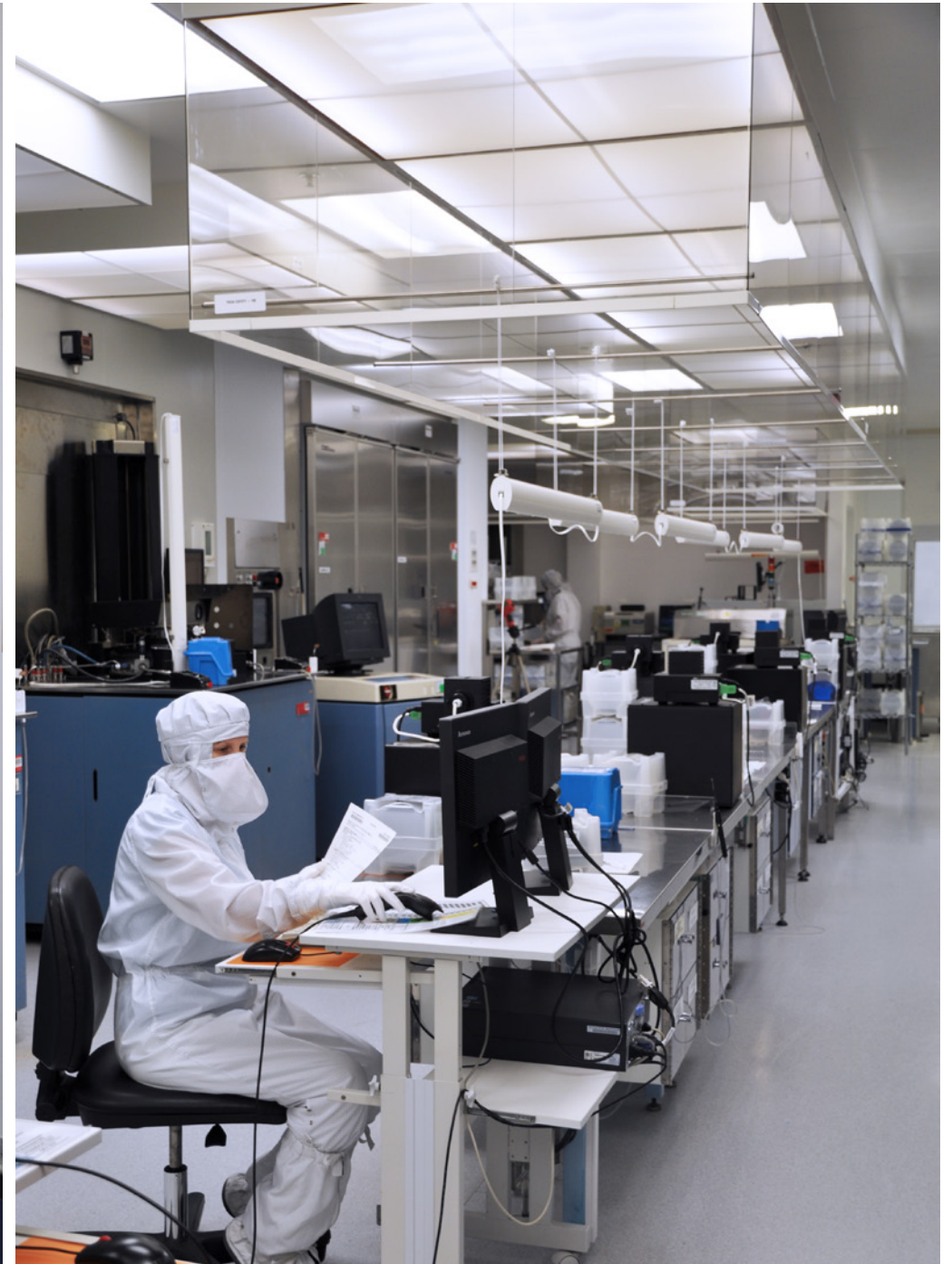
Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006



Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006



Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006



Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006



Extension of epitaxy workplace in the V12 object | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic | 2006